

Кристаллизация теллурида кадмия на охлажденной жидким азотом монокристаллической подложке

© **Беляев^{1*} Алексей Петрович, Рубец² Владимир Павлович
и Беляева² Светлана Александровна**

¹ *Кафедра физической и коллоидной химии. Санкт-Петербургская государственная химико-фармацевтическая академия. Ул. Проф. Попова, д.14, лит.А. г. Санкт-Петербург, 197376. Россия. Тел.: (820) 234-19-28. E-mail: Alexei.Belyaev@pharminnotech.com.*

² *Кафедра аналитической химии. Санкт-Петербургский государственный технологический институт (технический университет). Московский пр-т, 26. г. Санкт-Петербург, 190013. Россия. Тел.: (812) 494-93-71. E-mail: vladimir@mail.ru*

*Ведущий направление; †Поддерживающий переписку

Ключевые слова: гетроэпитаксия, сверхнизкие температуры, тонкие пленки, синтез из паровой фазы, структурные исследования, соединения A₂B₆.

Аннотация

Сообщается о гетроэпитаксии при сверхнизких температурах. Эффект образования упорядоченного монокристаллического состояния наблюдается при конденсации полупроводниковых пленок из паровой фазы на кристаллическую подложку, охлаждаемую жидким азотом. Продемонстрирована возможность целенаправленного воздействия на кристаллический тип и кристаллическое совершенство синтезируемых объектов.

Представлены результаты технологических экспериментов и структурных исследований пленок соединений A₂B₆, формируемых на подложке из слюды и кремния.

Приводятся диаграммы конденсации, микрофотографии, спектры дифракции электронов и рентгеновских лучей.